

	L #	Hits	Search Text	DBs
1	L1	1	10/692798	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
2	L2	1	10/704749	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
3	L3	1	10/624555	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
4	L4	2789	crystallization with apparatus	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
5	L5	308	4.ti.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
6	L6	355	laser same 4	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
7	L7	1	10/661600	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
8	L8	1	10/734248	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
9	L9	77494	amouphous or polycrystalline	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
10	L10	20114	semiconductor with 9	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
11	L11	933912	shift or shifting or shifter or shifted	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
12	L12	386613	mask or photomask or reticle	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
13	L13	232920	concave	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
14	L14	15423	11 with 12	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
15	L15	239	10 14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
16	L16	40	6 14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
17	L17	239	15 14	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
18	L18	30	16 15	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
19	L19	13	16 13	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
20	L20	232907	13 not 19	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO
21	L21	13	13 not 20	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO